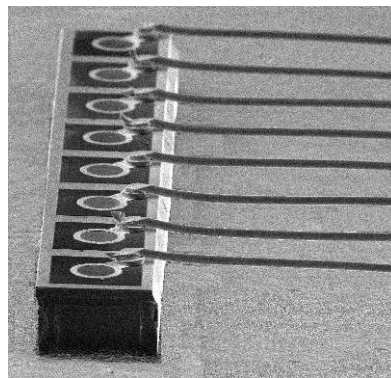


## 特長

- 光結合に有利な大受光径
- 低暗電流
- 1310nm, C-Band, L-Band に対応
- 高信頼性

## 用途

- LD, LED パワーモニタ
- 近赤外センサ
- パワーメータ
- 光計測 / センシング用途



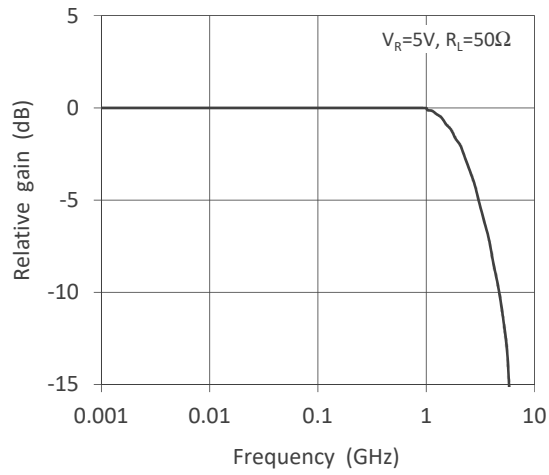
## 絶対最大定格

項目	記号	定格値	単位	備考
逆電圧	$V_R$	20	V	
最大光入力パワー	$P_{imax}$	10	mW	
順電流	$I_F$	10	mA	
動作温度	$T_{opr}$	-40 to +85	°C	結露なきこと
保存温度	$T_{stg}$	-40 to +85	°C	結露なきこと

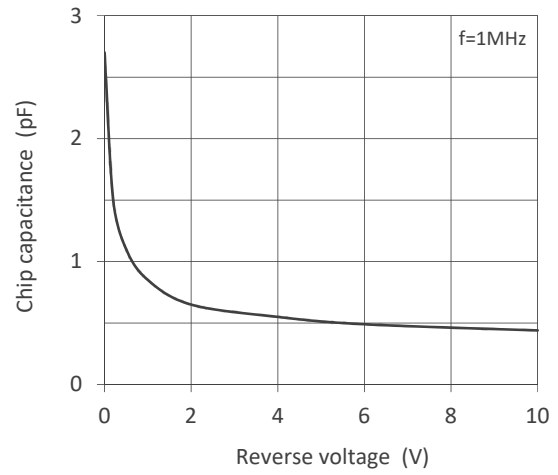
電氣的・光学的特性 (指定の無い場合  $T_a=25^\circ\text{C}$ )

項目	記号	Min.	Typ.	Max.	単位	条件
受光径	D	80			$\mu\text{m}$	
帯域幅	BW	1.0	2.0	-	GHz	$P_i=-10\text{dBm}$ , $V_R=5\text{V}$ Small signal modulation
受光感度	R	0.8	-	-	A/W	$\lambda=1310\text{nm}$ , $V_R=5\text{V}$
		0.85	-	-		$\lambda=1550\text{nm}$ , $V_R=5\text{V}$
隣接クロストーク	X	-	-35	-	dB	$V_R=5\text{V}$
暗電流	$I_D$	-	80	-	pA	$V_R=5\text{V}$
チップ容量	$C_{chip}$	-	0.6	0.8	pF	$V_R=5\text{V}$ , $f=1\text{MHz}$

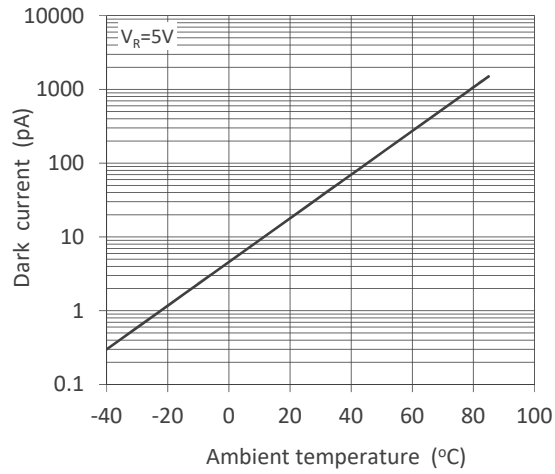
### Frequency Response



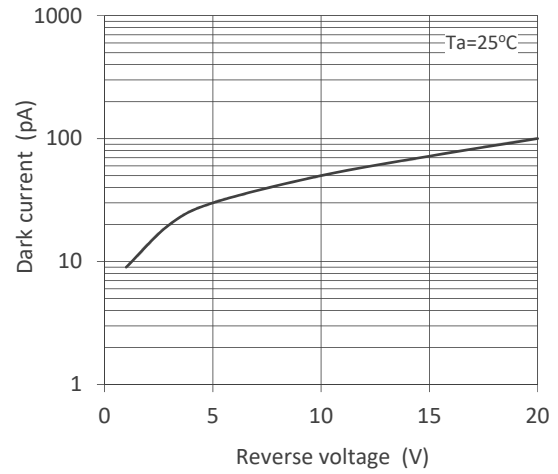
### Capacitance - Reverse Voltage



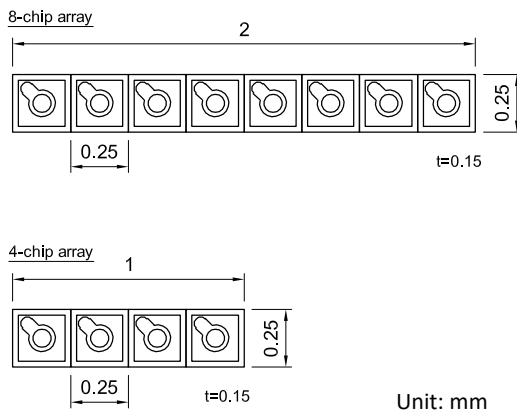
### Dark Current - Ambient Temperature



### Dark Current - Reverse Voltage



### Chip dimensions



- 製品の仕様、特性、データ、仕様材料、構造などは変更する可能性があります。ご使用の際は、必ず最新の仕様書をご用命のうえ内容をご確認ください。
- 本製品はRoHS指令(2011/65/EU)対応品です。



**Opto-technologies for the Future**

## 株式会社 京都セミコンダクター

本社：〒612-8362 京都府京都市伏見区西大手町307番地21

東京営業所：〒160-0022 東京都新宿区新宿1-34-3 第24スカイビル2F

関西営業所：〒612-8362 京都府京都市伏見区西大手町307番地21

Kyosemi Opto America Corp: 4655 Old Ironsides Suite 230 Santa Clara, California 95054 USA

恵庭事業所：〒061-1405 北海道恵庭市戸磯385-31

上砂川事業所：〒073-0200 北海道空知郡上砂川町上砂川70-1

TEL: 075-605-7311

TEL: 03-5312-5360

TEL: 075-605-7314

TEL: +1-408-492-9361

TEL: 0123-34-3111

TEL: 0125-62-3611